# 平成 14 年度

# 修士論文

# 酸化モリブデン膜の作製と基本的特性の評価

Preparation and characterization of fundamental properties of molybdenum oxide films

# 指導教員

河東田 隆 教授

電子・光エレクトロニクスコース 学籍番号 1055081 上條 富士太

平成15年1月27日提出

# 目次

第1章 序論	
1-1 背景と目的	3
1-2 モリブデンと酸化モリブデン	3
第2章 酸化装置	
2-1 はじめに	6
2-2 酸化装置設計の指針	6
2-3 酸化装置の作製	
2-3-1 酸化装置の設計	7
2-3-2 酸化装置の作製	12
2-3-3酸化装置の試験	14
2-4 まとめ	16
第3章 酸化モリブデン膜の作製	
3-1 はじめに	
3-2 基板の前処理	17
3-3 酸化	20
3-4 酸化条件	20
3-5 まとめ	21
第4章 酸化条件と酸化速度	
4-1 はじめに	22
4-2 膜厚測定	
4-2-1 膜厚測定装置	22
4-2-2 酸化モリブデン薄膜の処理	22
4-2-3 測定結果	23
4-3 酸化速度についての考察	24
4-4 まとめ	24

# 第5章 酸化モリブデン膜の評価

5-1 はじめに	25
5-2 走查型電子顕微鏡	
5-2-1 走査型電子顕微鏡の原理	25
5-2-2 走查型電子顕微鏡装置	26
5-2-3 測定結果	26
5-3 ラマン分光法	
5-3-1 ラマン分光法	28
5-3-2 ラマン分光法測定装置	30
5-3-3 測定結果	31
5-4 X 線回折法	
5-4-1 X 線回折法	34
5-4-2 X 線回折法測定装置	35
5-4-3 測定結果	36
5-5 測定結果の考察	38
5-6 まとめ	39

第6章 本論文の結論

# 参考文献

謝辞

#### 第1章

#### 序論

1-1 本研究の目的と背景

酸化物材料は古くから多くの物質、例えば酸化マグネシウム、酸化亜鉛、酸化カ ドミウム、酸化ニッケル、酸化スズ、酸化チタン、酸化バナジウム、酸化インジウム、チ タン酸ストロンチウムなどが研究されてきた。その一つに酸化モリブデンがあるが、電 子材料としての研究はほとんど行われていないのが現状である。特に電子材料とし て利用するには、良質な酸化モリブデン薄膜を作製し、薄膜の組成、結晶構造、成 長速度など基礎的な性質を明らかにする必要がある。そこで、酸化モリブデン薄膜 を作製するための酸化装置を作製し、酸化条件を変えて作製した酸化モリブデン薄 膜の評価を行うこととした。

- 1-2 モリブデンと酸化モリブデン
- (1) モリブデン
  - i 性質

モリブデン(molybdenum)は銀白色で延性があり、板ガラスより柔らかい金属で ある。金属結合半径 1.36Å、融点 2620°C、沸点 4660°C、体心立方構造 (a=3.147Å)をしており、極低温から高温に至るまで機構的に極めて強い。製法は 酸化モリブデン(VI)を熱しながら(900~1000°C)水素で還元する方法が一般的に用 いられる。常温では空気、酸素とは反応しないが、フッ素と反応し塩素とは徐々に 反応する。500°C 以上では酸化され酸化モリブデン(VI)になる。臭素、硫黄、炭素、 珪素、ホウ素とは高温で反応する。窒素とは 900°C 以上でもほとんど反応しない。 水蒸気と反応し、冷時にはモリブデンブルーを生じ、熱時には酸化モリブデン(IV) を生じる。多くの非金属と反応するが、しばしば組成のわからない生成物が生じる。 モリブデンは塩酸、希硫酸、フッ化水素酸には煮沸しても反応しないが、濃硝酸、 熱濃硫酸、王水、リン酸では反応して酸化モリブデン(VI)となる。モリブデンの化 合物は 2, 3, 4, 5, 6 価がしられている。ひとつの化合物の中に 2 つ以上の原子価 が共存することがあり、化学式はきわめて複雑である。

#### ii 用途

モリブデンは高融点金属の仲間であり、高い融点を持つため高温強度に優れ、 蒸気圧も低いことから耐熱材料として期待されている材料である。また、鉄鋼材料 の強化、耐食性の向上のための合金添加元素としても重要である。電気伝導・熱 伝導性が良好、熱膨張率が純金属中ではタングステンについで小さい、比較的 加工性が良い、溶融アルカリ金属を含む多くの媒質に対する耐食性が良好であ る等の物理的、機械的、化学的性質の総合的評価で他の高融点金属に比べ優 れている。そのためモリブデンは高融点金属の中では地殻における存在度(重量 比)が最も低いにもかかわらず、現在高融点金属中最大の生産量を誇る極めて重 要な金属である。モリブデンは 1893 年ドイツの化学者らによって初めて単体(元 素)として分離され、その高い融点とこれに伴う高温強度、低蒸気圧という特徴を 生かし、ランプ用光源およびその周辺材料、加熱炉の発熱体、反射板、支持板や 焼成用ルツボ、ボート等の耐熱構造部材。鉄鋼材料などの強度、硬さ、靭性、耐 磨耗性、耐食性の向上のための合金添加元素や、触媒材料、潤滑材、顔料等の 化学的用途。さらに、集積回路の配線材料、ヒートシンク、ドットピン、CT 電極等の 半導体、OA 機器、医療機器材料としての幅広い用途で使用されている。

(3) 酸化モリブデン

酸化数4,5,6価のモリブデン化合物が知られているが、このほかに不確実な化合物として2,3価の化合物、およびモリブデンブルーのような組成の明確でない化合物が知られている。もっとも安定な化合物は6価の化合物で、モリブデンまたは6価以外の酸化モリブデンを空気中で熱すると常にこのものが最終生成物となる。

- i. 酸化モリブデン(II)MoO の存在はきわめて不確実であり、純粋な物は分離されていない。
- ii. 酸化モリブデン(III)Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>は存在するとされているが、確実ではない。
- iii. 酸化モリブデン(IV)MoO<sub>2</sub> は灰褐色から黒色の単斜晶系結晶で、すこしゆがんだルチル構造をとっている。格子定数 a=5.610Å b=4.843Å c=5.526Å β=119.62°。電気の良導体で比抵抗は 8.8×10<sup>-5</sup>Ωcm(500°C)。500°C 以上では水素と反応して金属となる。塩化水素、酸、アルカリとは反応せず硫酸にわずかに溶ける。硝酸、硝酸銀とは反応し酸化モリブデン(VI)となる。
- iv. 酸化モリブデン(V)Mo<sub>2</sub>O<sub>5</sub>は暗紫色、水に不溶。硫酸、塩酸に難溶。常温で 伝導率が大きい。

v. 酸化モリブデン(VI)MoO3 は無色の斜方晶系結晶。融点は 795℃、沸点は 1155℃。格子定数 a=3.92Å b=13.94Å c=3.66Å。空気中できわめて安定だが昇 華しやすい。空気中でのシャク熱最終生成物は常にこの物になる。普通の酸に 不溶で、フッ化水素酸、濃硫酸に可溶。アルカリ、アンモニア水、炭酸アルカリ に溶け、水にはいくらか溶ける。

上記の生成物のほかに化合物 MoO2とMoO3の中間の組成、MonO3n-1の形で 表せる Mo3O8,Mo8O23,Mo9O26,Mo4O11,Mo17O47,Mo5O14,Mo18O52 などが知 られ、多くは青から色に強く呈色している。

#### 第2章

#### 酸化装置

2-1 はじめに

良質な酸化モリブデン薄膜の作製のために酸化装置の作製を行った。酸化装置 作製の指針を決め、それに基づき作製を行った。

2-2 酸化装置設計の指針

酸化モリブデン薄膜の作製で重要となる条件は、酸化温度、酸化時間、酸素流量である。酸化装置は少なくともこの3つの条件をそれぞれ制御できることが求められる。下記に3つの条件を制御するための達成すべき内容と理由を記す。

i 10×10mm 程度のモリブデン基板を一度に酸化できること。

作製、測定のしやすさから 10×10mm としている。酸化モリブデン薄膜の評価に X線回折法、ラマン分光法、膜厚測定と電気測定を入れた場合、2枚以上の試料が必要になるため、数枚同時に酸化できることが望ましいからである。

- ii 800°C 程度の加熱ができること。
   酸化モリブデン(MoO<sub>3</sub>)の融点が 795°C であることから、800°C 程度までの
   加熱が必要になるからである。
- iii 800°Cまで60分以内で到達すること。
   酸化温度まで到達する時間が長ければ、時間と酸素、窒素を無駄にするからである。
- iv 速応性・安定性よく酸化炉の温度を制御できること。 酸化温度が不安定では、酸化モリブデン薄膜の成長に影響が出ると考えられるからである。
- v 均熱性が広いこと。 均熱が狭い場合、一枚のモリブデン基板上で温度むらが生じ、不均一な薄 膜成長になると考えられるからである。
- vi 窒素と酸素が流せ、それぞれ流量調節ができること。 900℃程度でもモリブデンとほとんど反応しないといわれている窒素を流し、 酸化開始前に酸化が起きないようにするためである。また、酸素流量は酸化モ リブデン薄膜作製の条件の一つであるため、流量調節ができなければならな い。

vii 真空に引くことができること。

モリブデン基板の挿入などで、作業部分に入った気体や水分など酸化に必要のない不純物を排気できるようにするためである。

viii 漏れを少なく抑えること。

漏れが大きい場合、酸化中作業部内に不純物が入り込み、酸化に影響を及 ぼすと考えられるからである。

- 2-3 酸化装置の作製
- 2-3-1 設計

酸化装置設計の指針で決めた内容を満たすように、酸化装置の各部分ごとに設計を行った。

- (1) 酸化炉に関して
- i 到達最高温度

酸化モリブデンの昇華温度は700°C程度であるが、作業部分の焼きだしを行うためさらに高い温度まで加熱させる必要がある。良質な酸化を行うため作業 部内を酸化モリブデン薄膜作製で想定される酸化温度以上で過熱し、酸化中 に作業部内壁から不純物が放出されないよう焼きだしを行う。焼きだし温度は 酸化温度より100°C程度の温度で十分とし、800°Cとした。また、加熱時間が長 ければ多くの酸化モリブデン薄膜を作製できないため、800°Cまで 60 分以内 に到達する。

ii 作業部分の材質

モリブデン基板を入れ酸化を行う作業部分は高温になる。焼きだしの温度は 800℃となるため、作業部分の材質は高温耐えるガラス材料となる。化学実験 等で使用されるガラスの材質にはホウケイ酸ガラス(硬質ガラス 商品名:パイレ ックス)、石英ガラスなどがあるが、パイレックスは 450℃ 以下の使用に限定され、 それ以外の材質はパイレックス以下の使用温度となる。石英ガラス 1000℃ は 程度までの使用可能なため、作業部分の材質は石英ガラスとする。

iii 酸化炉の形と大きさ

モリブデン基板を温度むらなく加熱できるように、酸化炉の形は一般的な形である円柱とし、酸化炉中心の同心円上に石英管を通せる形とする。その石英管にモリブデン基板を置き、酸素を流すようする。モリブデン基板を作業部分(石英管)内に挿入するさい、出し入れがしやすいように台に乗せるようにする。 台は厚さ2.5mmの石英を張り合わせ、25×22×5mm大きさとし、10×10mmのモリブデン基板を2枚乗せることができる台とする。この台を挿入できるよう石英管の内径は約28mmとする。

さらに、酸化モリブデン薄膜を一回に多量に作製することを想定し、石英管の縦方向に 4 枚並べて酸化できるようにするため、温度の安定した領域は

40mm 以上確保する必要がある。温度の安定した領域は酸化炉の型ごとに違うが、酸化炉の全長が300mm 程度あれば50mm 以上の安定した領域を得ることができるとし、酸化炉が長さは300mm 程度とする。石英管は酸化炉の2倍の長さ600mmとし、厚さ1mmの直径30mmとする。

iv 使用電源

酸化炉の電源は、指示調節計やマスフローコントローラの電源と共通化し、 特別な設備を必要としない一般家庭向けの100V 60Hz とする。

- (2) 配管系に関して
- i 酸化時間と酸素流量の制御方法

酸化時間を制御するには、酸化温度に到達するまで石英管内に酸素が無け ればよい。そこで、酸化温度に達するまで窒素を流し続け、酸化温度で酸素を 流し酸化時間終了時に、酸素を止め窒素で押し出すようにする。酸素、窒素の 流れはバルブの開閉により行うことができる。さらに、窒素と酸素の流すライン にマスフローコントローラを取り付けることにより、酸素と窒素の流量調節が可能 となる。

ii 配管

配管の材質にはアルミニウム合金やステンレス鉄鋼などがあるが、アルミニウム合金は高価であるためステンレス鉄鋼を使用する。配管の大きさは加工のしやすさと適度な硬さから 1/4in とする。

配管と配管との接続に用いる主な継ぎ手には CAJON 社の VCR と Crawford Fitting 社の Swagelok がある。VCR では配管の長さを厳密に決めなければ、配管を接続できず、溶接の加工が必要となる。しかし、Swagelok では配管が数ミリ短い場合でも問題なく接続でき溶接は必要ない。作製する酸化装置は超高真空系ではないため、継ぎ手は Swagelok で十分である。

#### 継ぎ手

VCR はガスケットでシールする構造をしており、袋ナットでグランドと呼ばれる 丸みを帯びたエッジ部を締め付ける構造になっている。全て金属製であるため に高温のベーキングが可能であり、また、シール性も良いため、超高真空系へ のガス導入配管用継ぎ手として用いることができる。Swagelok のシールはフロ ントフェルールと呼ばれる穴の開いた円錐形のさやの先端を、挿入した管の外 面と密に接触させ、かつ、フロントフェルールの円錐面をボディ内面に密に接 触させている。挿入する配管の材質をあまり選ばないという利点がありますが、 シール性能はVCRに較べると劣るため、使用可能なのは高真空系までであ る。 iii ゲージポート

石英管との接続には、石英管に合わせたステンレス鋼削りだしのゲージポートを使用し、配管と接続させるためのSwagelokを溶接させる。ゲージポートを直接配管に接続すると石英管からの取り外しができなくなるため、ゲージポートと配管の間に自由に曲げることのできるフレキシブルチューブを入れ、取り外しを容易にする。Oリングは内側で石英管を、下部で本体のテーパ部をシールしており、金属製のリングを介して袋ナットが Oリングを押さえつける構造になっている。そのため、内圧によりゲージポートが外れるが、圧力計を取り付け内圧が高くならないよう調節することで解決できる。

ゲージポートに使用するOリングは、使用温度が270°C程度と耐熱性に優れ たパーフロロエラストマー(商品名:カルレッツ)が望ましいが、消耗品かつ高価 であるため使用温度が150°C程度のフッ素ゴム(商品名:バイトン)とした。その ため、酸化炉の熱でOリングが溶ける恐れがあるが、長い石英管を使い、ゲー ジポートを酸化炉より離せば問題ない。

iv 流量制御

気体の流量制御には、差圧流量計、面積流量計、渦流量計、熱式質量流量 計を使ったものがある。酸化モリブデン薄膜作製に必要な酸素流量はわからな いため、流量は広い範囲 50~1000sccm 流すこととする。差圧流量計では最大 最小流量比が 3:1 程度までなので使用できない。また、面積流量計は垂直に 取り付けなければならず、取り付け位置に制限が出る。渦流量計では低流量 で信号が消えるためシステムの設計が複雑になる。熱式質量流量計(マスフロ ーコントローラ)では、そのような問題がなく操作も容易なことから、流量制御に は熱式質量流量計を使用することにする。ただし、汚れに弱いため扱いに注意 が必要になる。

マスフローコントローラ

マスフローコントローラは正式名称をサーマルマスフローコントローラと言い、マスフローメーターに流量コントロールバルブ付加した構造を持った電子式の質量流量制御器である。マスフローメーターの流量検出センサーは、細管の外側に発熱感温抵抗線が2個所で巻かれていて、この細管にガスが流れると、上流側の発熱感温抵抗線からは熱が奪われ、下流の発熱感温抵抗線には上流からの熱が伝わり、上流側と下流側の発熱感温抵抗線に温度差が生まれる。この温度差はガスの流量に比例するので、温度差から流量を計算し電気信号にすることができる。広範囲の流量域で使用できるために、流量検出センサーに流れるガスをバイパスさせ流量を制限するバイパスキャピラリーを取り付けてある。流量設定器により設定された流量信号とセンサーからの流量信号が比較され、この比較からソレノイドにかかる電流を制御する。これにより、流量設定器とセンサーからの流量信号が等しくなるようにバルブの開度が調整され、設定した質量流量が自動的に得られるようになっている。

v 真空

モリブデン基板の出し入れを行うことにより、石英管内部は酸化に用いる酸素と窒素以外の気体や水分が含まれた空気と接触する。特に、水分は酸化速度を促進する働きがあり、この水分は意図的に制御できないため酸化モリブデン作製に影響を与えると考えられる。バックグラウンドを下げた状態で酸化を行うため、酸化装置の下流側に真空ポンプを取り付け、石英管内部から空気を排気できるようにする。真空度は低真空の100Pa程度とする。石英管内を真空にする場合、真空ポンプとの間の配管、バルブ、継ぎ手などにより、気体の流れやすさ(コンダクタンス)が変化する。コンダクタンスにより、石英管出口では真空ポンプの排気速度より遅い排気速度になり、これを実質排気速度という。コンダクタンスを上げるためには配管を短くし、真空ポンプの排気速度は大きくすればよい。作業部分から真空ポンプで十分である。

酸化は大気圧で行うため、真空にした配管系を大気圧に戻す手順が必要となる。空気の逆流を防ぐため配管系に窒素を流し大気圧以上にしてから排気を行う。そのため負と正の圧力が測れる連成計が必要となる。連成計は正確な 圧力測定は必要ないと思われるため測定範囲は-0.1~0.1MPa 程度とする。

連成計

連成計は正および負のゲージ圧を測定できる圧力計の一種である。絶対真 空をゼロ基準として現した圧力を絶対圧といい、大気圧または周囲の圧力をゼ ロ基準として現した圧力をゲージ圧という。ゲージ圧と絶対圧には、絶対圧=大 気圧+ゲージ圧の関係がある。特殊な場合を除き工業的には、ゲージ圧を圧 力としている。

#### 真空到達度

連成計では 100kPa 以下の測定はほぼ不可能なため、石英管内の実際の圧 力がどの位かは測定できない。そこで、計算によりおおまかな真空度とその真 空に達するまでの時間を見積もった。

石英管から真空ポンプの間には、継ぎ手、バルブ、フレキシブルチューブ、 真空チューブが接続され、それぞれの部品に気体の流れやすさであるコンダク タンスが存在する。長さ1、直径Dのチューブに20℃の空気を流した場合のコ ンダクタンスFは

$$F = 1355 \left(\frac{D^4}{l}\right) \overline{P}$$

ただし、 $\overline{P} = \frac{P_1 + P_2}{2}$ である。 $P_1$ は石英管での圧力。 $P_2$ は真空ポンプの到達圧力となる。

真空ポンプの排気速度 S はチューブなどのコンダクタンスにより、石英管入り ロでは遅くなるため、実質的な排気速度である実行排気速度 S<sub>c</sub>は

$$S_c = S \frac{F}{F+S}$$
  
 $\geq r_c \gtrsim_o$ 

石英管周りに一定の漏れLがあり、実行排気速度Scをもつ真空ポンプによって排気する場合、

$$2.3 \log \left(\frac{P - P_{\infty}}{P_0 - P_{\infty}}\right) = -\frac{S_c t}{C}$$

となる。P0 は初期圧力で、P は排気開始後の時間 t における圧力、また  $P_{\infty} = \frac{L}{s}$ 

継ぎ手、バルブ、フレキシブルチューブ、真空チューブのコンダクタンスは 1/4in チューブと同じとし、石英管から真空ポンプの間の長さ1は約3mと仮定 する。1/4in チューブの直径は約4mmで、石英管の体積は0.370である。使用 している真空ポンプの排気速度Sは60[l/min]、到達圧力は0.1Paとし、漏れの ない理想状態と仮定し計算を行うと、100Paまでは約3分となる。長さ1を3m以 下に抑えれば十分な排気速度が得られる。しかし、実際の使用では、一定の 漏れが発生するため目的の圧力までの到達時間は長くなる。

#### vi ガスシリンダーと圧力調節器

モリブデン基板の酸化において酸素は酸化時間だけ流せばよいが、窒素は 酸化炉の加熱を始めてからモリブデン基板取り出しまで流し続けなければなら ない。総流量一定、酸化までの加熱時間を30分、酸化時間を60分、試料を取 り出すまでの時間を360分とすれば、窒素は酸素の14倍必要となる。ガスシリ ンダーに圧縮されたガスの純度は時間とともに徐々に悪くなるため長期間にわ たっての使用はできない。純度を保つため、消費量の多い窒素は46.70、少な い酸素は100のガスシリンダーを使用することにする。

圧力調節器は汎用の小型圧力調節器とする。ただし、付属の圧力計ではガ スシリンダー交換時に圧力調節器までの配管内を真空に引く作業を行うため 壊れる恐れがある。そのため、2 次側の圧力計は連成計とする。ただし、圧力 調節器用の圧力計は脱脂処理したもの使用する。

vii バルブ

酸素、窒素の流量はマスフローコントローラが行うため、流量調節の能力は 要らず開閉のみのダイヤフラム・バルブとする。

- (3) 電力系に関して
- i 温度制御の方法

一般的な温度制御では、酸化炉内部の温度から指示調節計とパワーデバイスの組み合わせが用いられている。この組み合わせは一般的で、入手が容易である。

ii 指示調節計

再現性よく酸化モリブデン薄膜を作製するために、指示調節計は温度上昇時のオーバシュート、ハンティング、定常偏差、さらに外的要因による過渡状態を抑えることができる PID 方式とする。指示調節計が酸化炉内の温度を測定するための熱電対には、使用範囲が 0~1000℃付近までのクロメル・アルメル熱電対を使用する。

iii パワーデバイス

交流を高速スイッチングで制御する必要が無いため、パワーデバイスはサイ リスタ(商品名)とした。サイリスタにはゼロ電圧スイッチング方式と位相制御方式 がある。ゼロ電圧スイッチング方式はノイズが少ないのが特徴だが、酸化炉装 置には必要なく位相制御方式とする。

2-3-2 作製

酸化炉は設計で決めた内容を満たす既存品を流用した。酸化炉の長さ 336mm で直径 30mm の石英管を挿入でき酸化炉の中心付近に熱伝対の差込口のある構 造になっている。仕様は 100V 8A 0.8kW 1100°C である。指示調節計は既存品の EC5500B(大倉電気株式会)、サイリスタは PAC-31Z 15A(株式会社シマデン)を使用 した。しかし、サイリスタは酸化炉に合わせた 100V 動作のものが入手できず 200V と なっている。そのため、100V と 200V の 2 種類の電圧が必要となった。

酸化温度とは石英管内部のモリブデン基板を置く位置の温度であるが、熱電対 はその位置に取り付けることは物理的に不可能であり、酸化炉の中心から少し離れ た位置に取り付けることになるため、熱電対の測定した温度とモリブデン基板の温度 には差が生じることとなる。指示調節計に入力する値を変化させ、熱電対の温度と モリブデン基板を置く位置の温度を同時に測定し、実際の酸化で指示調節計入力 する温度を測定した。モリブデンの酸化は 500°C 程度から始まると言われ、焼きだし 温度が 800°C であるから、温度の測定範囲は 50°C 刻みで 500~800°C の範囲で行 った。温度測定は、下流側のゲージポートを外して熱電対を 16cm 挿入し、モリブデ ン基板を置く位置の温度を測定した。石英管内は気体の流量により温度が変化する ため、酸化条件の1つである酸素流量は、窒素も流す場合を考え総流量 500sccm と 決めた。窒素を 500sccm 流した状態でモリブデン基板を置く位置の温度と熱電対の 温度を測定した。また、この作業と平行し指示温度計の PID 値をオートチューニング により決定していった。

表 2-1窒素500sccm時の指示調節計入力値

到達温度	500℃	550°C	600°С	650°С	700°C	800°C
温度計	453℃	495℃	550°C	589℃	650°С	745°C
Р	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
Ι	2.04	2.23	1.73	1.69	1.59	1.35
D	0.51	0.55	0.43	0.42	0.38	0.33

図 2-1 は完成した酸化装置の配管図の概略図である。気体の逆流などによる汚染被害を最小限にするため、各部分はバルブで仕切る構造にしてある。No.9 バルブは、真空ポンプ停止時に発生するガスミストの逆流を防ぐために取り付けてある。



図 2-1 酸化装置の配管系の概略図

配管、継ぎ手や石英管は油脂や埃、特に配管はバリ取りで発生した屑によって汚 れているため洗浄を行う必要がある。配管と継ぎ手はアセトン、メタノール、純水で超 音波洗浄し、窒素ブローとドライヤーによる加熱で部品に残った水分を取り除いた。 ガスシリンダーから酸化装置までの配管の引き回しでは、振動により継ぎ手が緩むこ とがあるので、ガスシリンダーから酸化装置までの配管の長い部分は、配管固定用 に骨組みを組み、固定をした。

#### 2-3-3 試験

作製した酸化装置は、酸化炉の均熱性、加熱時間、到達最高温度、配管の漏れ、耐圧の試験を行った。

i 酸化炉の均熱性

図 2-2 は温度と酸化炉下流側からの距離である。酸化炉の下流側から 15~20cmの5cm間で温度勾配がほぼ無くなっており、設計どおりの範囲を得る ことができている。



ii 到達最高温度と加熱時間

図 2-3 は温度と加熱時間の関係である。定格 800W の運転では、設計で決めた 60 分で 800°C を達成できないため、出力は 200V 6A との 150%過負荷になっている。10 時間の試験運転を数回繰り返し問題は起きず、火災の危険は無い。過負荷運転ではあるが、60 分で 800°C 以上と十分な温度上昇速度が得られている。



#### ⅲ 配管の漏れ

漏れ(リーク)テストは圧力調節器から石英管手前のバルブ(No.0)までの上流 側、酸化を行う石英管から真空ポンプ手前のバルブ(No.9)の下流側までと分け て測定を行った。上流側は加圧することができるため、リーク箇所を特定できる 発泡法とし、下流側は加圧するとゲージポートが石英管から外れるため真空放 置法とした。

#### 上流側

No.0,7 バルブを閉じ No.1,2,3,4 を開いた状態で、窒素と酸素ラインに窒素を 2.5Mpa をかけ、継ぎ手部分に石鹸水を付けて気泡が発生するか調べた。その 結果、気泡は認められなかった。気泡が認められなかったことから大きなリーク は無いと判断してよい。

#### 下流側

No.0,8,9,10 バルブを閉じた状態で、真空ポンプを作動させる。No.9 バルブを 開き窒素を流す。連成計の値が-0.5MPa 程度にする。そのまま放置し、30分で 1kPa の圧力上昇が見られた。一日放置しても大気圧には戻らないことから、酸 化には十分であると考えられる。

iv 耐圧

排気側のバルブを閉じた状態で窒素を流し、配管系の圧力を上げていった。 その結果、10kPa 程度でゲージポートが石英管から外れた。10kPa という圧力 は、使用した連成計では判読限界に近く操作慣れが必要ではある。

2-4 まとめ

設計指針で決めた内容をすべて満足できる装置となった。しかし、過負荷運転は 好ましいものではなく今後の課題である。

#### 第3章

#### 酸化モリブデン薄膜の作製

#### 3-1 はじめに

酸化モリブデン薄膜の作製工程は、大きく分けて前処理と酸化の2工程となる。 前処理では、モリブデン板からモリブデン基板を切り分け、有機溶剤による洗浄、自 然に発生した酸化モリブデン膜の除去を行う。酸化では、酸化炉の真空引き、酸化 温度までの加熱、モリブデン基板の酸化、冷却、取り出しとなる。

モリブデン基板の酸化条件は、酸素流量一定とし、酸化温度と酸化時間を変化させさせている。

#### 3-2 基板の前処理

i モリブデン基板の切り分け

モリブデン基板は、0.10×500×500mmのモリブデン板(株式会社ニコラ)を金切り ばさみを使い10×10mmの大きさに切り分けて使用した。モリブデン基板の反りは酸 化後の膜厚測定に影響がでるため、反りが少なくなるように切断する必要がある。カ ッターで切ることができればモリブデン基板の反りは少なくできるが、モリブデンは硬 く延性があるため切り分ける事はできなかった。本研究ではモリブデン基板の反りを 少なく切断する方法が無く金切りばさみを使い切断を行った。

ii 有機溶剤による洗浄

購入直後のモリブデン基板であっても表面は油脂、埃などで汚染され自然に生じた酸化モリブデンの膜に覆われている。長時間大気中に曝すと表面に油脂と埃が付着し、金属の銀白色から黒く変色してしまう。このような、油脂や酸化膜のある状態では、再現性よく酸化膜を成長させることは困難であると考えられる。そこで、油脂や酸化膜を取り除く前処理が必要になる。油脂の除去には、数多くの種類の油脂や樹脂を溶解するメタノールを使用した。メタノールのみによる洗浄では、メタノールに溶解した油脂がメタノールの滴の周辺で凝集する場合があるためメタノールでの洗浄後、メタノールとよく混ざる純水による洗浄を行った。水分の付いたモリブデン基板を濃硫酸に入れると危険であるため、モリブデン基板に残った純水は窒素ガスを使い強制的に乾燥させた。効率的な洗浄を行うため、アセトン、メタノールそして、純水による洗浄は超音波洗浄装置を使用し、洗浄時間は5分間にした。

モリブデン基板表面の酸化膜は、酸化モリブデン(MoO<sub>2</sub>)と一番多く作られている と考えられるモリブデンの最終生成物である酸化モリブデン(MoO<sub>3</sub>)を溶かすと言わ れている濃硫酸を使うことにした。濃硫酸はモリブデンとほとんど反応しないが、モリ ブデン基板表面が不必要に荒れないようモリブデン基板を処理する時間は3分間と した。モリブデン基板に付いた濃硫酸は 150ml 以上の純水で濯いだ。モリブデン基 板が水で酸化する可能性も考えられるため、濯ぐ時間は 30 秒以内に抑え、窒素で 乾燥をさせた。モリブデン基板を純水に浸けておくと、表面にモリブデンブルーと呼 ばれる酸化モリブデンの一種が一面に現れることがある。

前処理の工程

アセトンで5分間の超音波洗浄 メタノールで5分間の超音波洗浄 純水で5分間の超音波洗浄 窒素で乾燥 濃硫酸に3分間浸す 150ml以上の純水で濯ぐ 窒素で乾燥

有機溶剤

メタノーハ	$\vee$ (CH <sub>3</sub> OH)
分子量	32.0
比重	液体0.793
融点	−97.78°C
沸点	64.65°C

最も簡単な化学構造のアルコー ルで、多くの種類の油脂や樹脂 を溶解する無色の可燃性液体。 溶解した汚れがメタノールの滴周 辺で凝集する場合がある。

<b>TTY 1</b>
4/27

#### <u>硫酸(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</u>

分子量	98.1
比重	94%以上 1.84
融点	88.7% 247℃
沸点	88.7% −7.2°C

濃硫酸はきわめて強い脱水作用 とそれにともなう腐食作用があ る。無色の液体で、粘性が大き い。不揮発性ので、水には無限 に溶ける。水に溶ける時、著しく 発熱する。

#### **3-2-1** 前処理の洗浄効果

メタノールとメタノール同様数多くの種類の油脂や樹脂を溶解するアセトンとの洗 浄効果について比較を行った。図 3-1 は、未洗浄、アセトン洗浄後、メタノール洗浄 後のラマンスペクトルである。ラマン分光法の原理等は第5章で述べる。未洗浄のモ リブデンでは波数 746, 859, 955 cm<sup>-1</sup>付近にピークが現れる。アセトン洗浄後もこの ピークに変化は見られない。メタノール洗浄後には、金属特有のピークの無いブロ ードなグラフとなった。未洗浄とアセトン洗浄後の表面は灰色をしているが、メタノー ル洗浄後には銀白色への変化が確認できる。有機物質と考えられる汚れの原因物 質の同定には至っていないが、未洗浄そしてアセトン洗浄後のモリブデン基板には、 アセトンに溶解せず、メタノールに溶解する有機物質が付着していると考えられる。 よって、モリブデン基板の有機溶剤による洗浄はメタノールが効果的ということがわ かる。

濃硫酸による効果はラマン分光法、X 線回折法により測定したが違いは測定できなかった。モリブデン基板表面を覆う自然に生じた酸化モリブデン薄膜が非常に薄いため測定できなかったと考えられる。



図 3-1 洗浄過程におけるラマンスペクトル変化

#### 3-3 酸化

ii 真空引き

加熱を始める前に、真空ポンプで酸化炉内部を20分程度引き50Pa以下の真空にする。バックグラウンドを下げた状態で酸化が行えるようにする。モリブデン基板の出し入れのとき、酸化炉内部は空気と接触してしまう。空気には酸化に用いる酸素と窒素以外の気体や水分が含まれている。特に水分がある状態で酸化を行うと、酸化速度が速まり膜質が悪化する恐れがある。また、水分は酸化を行う環境により変わるので、膜質のばらつきの原因になると考えられる。

ⅲ加熱

酸化炉に電流を流し加熱を開始する。このとき、酸化内を真空にしたら真空ポン プを止め、窒素を流し酸化炉内を大気圧にもどす。酸化温度に達するまでは、窒素 を流し続けてモリブデン基板の酸化が起こらないようにしておく。流量は酸化条件で 決めた酸素と窒素を合わせた量にする。

iv 酸化

酸化温度に達したら、酸素を流し酸化を開始する。流量の変化によりモリブデン 基板の温度が変化することを防ぐため、総流量は変化させないように窒素の流量を 調節する。酸化の終了は、酸化炉への電流を切るほか、酸素の流れを止め窒素だ けにする。このときも、気体の総流量は変化させないようにする。窒素で酸素は酸化 炉内から押し出されモリブデン基板の酸化が停止する。

v 冷却

モリブデンの酸化が始まる温度が 500℃程度といわれているが、それ以下でも酸 化していると考えられるため、酸化炉内部が 100℃程度に冷めてから、モリブデン基 板を取り出す。取り出したモリブデン基板は、各種測定までアクリル製のサンプルケ ースに入れて保存する。

3-4 酸化条件

酸化膜の成長は酸化温度、ガス流量、酸化時間の 3 つの条件が重要となる。本 研究ではガス流量の条件は一定とし、酸化温度と酸化時間のみを変化させ酸化を 行った。酸化温度の下限は余裕を持たせモリブデンの酸化温度といわれている 500℃より低い 50℃低い 450℃からとした。酸化モリブデン(MoO<sub>3</sub>)の融点は 795℃だ が、膜質が悪くなると考えられるので融点より 100℃低くした。各酸化温度は 450~ 700℃までを 50℃毎とし、酸化時間は 30, 60, 120, 240 分とした。酸素は窒素と1 対 1 の混合ガスとして、総流量 500sccm とした。

各酸化条件で作製したモリブデンのうち、酸化温度が 700℃のものは原型を留め ないほど溶けた状態になっていた。よって、酸化モリブデン薄膜の作製は 700℃未 満で行うこととした。

表 3-1 モリブデンの酸化条件

温度(℃)	時間(min.)
450	30
500	30
550	30
600	30
650	30
550	60
550	120
550	180

3-5 まとめ

前処理でアセトン、メタノール、純水、濃硫酸による各種洗浄の過程をラマン分光 法で測定した。その結果、モリブデン基板の汚染物質除去に十分な効果があること がわかった。

良質の酸化モリブデン薄膜は 700℃付近以上の高温では作製できないことがわかり、酸化温度は 650℃以下と決定した。

#### 第4章

### 酸化条件と酸化速度

4-1 はじめに

膜厚の再現性、制御、酸化速度を明らかにするため、作製した酸化モリブデン薄 膜は、エッチング処理後、触針式表面形状測定器により薄膜の測定を行った。

#### 4-2 膜厚測定

4-2-1 測定装置

酸化モリブデン薄膜の厚さは、触針式表面形状測定器(商品名:Dektak)を使用し て測定を行った。Dektak はダイヤモンド触針を試料表面に接触させ、触針に加わる 圧力を一定に保ちながらトレースする。そのときに生じる触針の上下の動きを記録す ることで、試料表面の形状、膜厚段差、表面あらさ、うねりを測定する装置である。触 針式であるため試料がやわらかい場合、表面に傷を付けてしまう欠点があるが、原 子間力顕微鏡など他の試料表面を測定する装置に比べ、垂直分解能力を維持した まま測定長さ大きくとるがことができる。Dektak の垂直分解能力は高く、0.5nm 程度 である。一般的な原子間力顕微鏡の場合、測定長さは1µm ほどしかないが、Dektak では 30mm 以上測定ができる。

#### 4-2-2 酸化モリブデン薄膜の処理

膜厚を測定するには表面の一部をエッチングし酸化モリブデン薄膜とモリブデン 基板の境を明確にする処理が必要になる。エッチング液には、水酸化ナトリウム水 溶液を使用した。水酸化ナトリウム水溶液以外の塩酸、硝酸、濃硫酸、王水では数 分間浸けても酸化モリブデンに変化は見られなかった。王水ではモリブデン基板が 溶けてしまった。エッチング用のマスク材料は宗電子工業株式会社のエレクトロンワ ックスを使用した。エレクトロンワックスを器に入れ 150℃程度に加熱し溶かす。エレ クトロンワックス温度が低い場合、酸化モリブデン薄膜となじみにくくマスクが必要以 上に厚くなる。溶かしたエレクトロンワックスに酸化モリブデン薄膜を対角線までゆっ くり漬けゆっくり引き上げエレクトロンワックスが固まるまで冷やす。約 0.2mol の水酸 化ナトリウム水溶液に浸し酸化モリブデン薄膜表面に変化が見られなくなるまでエッ チングを行う。エッチングの終わった酸化モリブデン薄膜は純水で洗浄させる。超音 波洗浄器を用いると酸化モリブデン薄膜が剥がれる場合があるため濯ぐだけに留め る。窒素で乾燥させてから沸騰させたアセトンに入れエレクトロンワックスの除去を行 う。エレクトロンワックスはアセトンに対する溶解度が低く、350ml のアセトンで酸化モ リブデン薄膜十数個程度の処理しかできない。 4-2-3 測定結果

膜厚にはばらつきがあるため、酸化モリブデン薄膜を各酸化条件で 2~7 個作製 し測定を行っている。図4-1は温度依存による膜厚の変化である。グラフの四角の点



はその条件での平均値、エラーバーの範囲は標準偏差である。酸化温度が上昇するにしたがい、薄膜の膜厚は厚くなり、膜厚のばらつきが大きくなっていく。550℃を超えた辺りからは薄膜の膜厚は薄くなる。ばらつきの大きさは 600℃を最大にして小さくなっていく。

図 4-2 は膜厚の時間依存である。時間の経過とともに薄膜の膜厚は厚くなっている。どの酸化時間でもばらつきの大きさはほぼ一定になっている。

#### 4-3 酸化速度についての考察

酸化炉内でモリブデン基板を熱すると、酸素分子が表面に衝突し酸化反応が起 こり、酸化膜が形成される。この酸化モデルがシリコンと同様であると仮定するなら、 酸化膜が薄い酸化の初期段階では、酸化膜の厚さは衝突した分子数とともに増加 するため酸化時間に比例する。酸化膜が厚くなると、成長した酸化膜が酸素分子と モリブデンとの接触を妨げるようになる。この状態で酸化温度とガス量が一定とすれ ば、酸化膜の暑さは酸化時間の平方根に比例することになる。

しかし、酸化モリブデン薄膜は、酸化する毎のばらつきが大きく、プロットの数が少ないためシリコンの酸化モデルに当てはめた成長速度を求めることは難しい。そこで、 図4-2に直線を引き直線の傾きから酸化膜のだいたいの成長速度を求めた。その結果、酸化温度 550℃での酸化モリブデン薄膜の成長速度は約 0.11µm/min ということ が分かった。また、直線とプロットの関係から酸化温度 550℃のときは、酸化時間 30min 以下が酸化の初期段階と考えられる。

550℃で酸化させた酸化モリブデン薄膜を再び 550℃で過熱させると、酸化膜が 薄くなりモリブデン基板が現れる。このことから、酸化時間 30nim のとき、酸化温度 550℃以上で膜厚が薄くなる原因は、酸化モリブデンの成長速度より酸化モリブデン の昇華速度が速くなり、膜厚が薄くなったためと考えられる。

4-4 まとめ

エッチング処理は、すべての酸化条件で作成した薄膜にに適応できた。

酸化モリブデン薄膜の成長速度は酸化温度 550℃で約 0.11µm/min であること分かった。

#### 第5章

#### 酸化モリブデン膜の評価

5-1 はじめに

作製した酸化モリブデン薄膜の基礎的な評価は、走査型電子顕微鏡、ラマン分光法、X線回折法によって行った。

5-2 走査型電子顕微鏡による評価

5-2-1 走査型電子顕微鏡の原理

試料に電子線を照射すると、図 5-1 に示すように試料の表面から、2 次電子、反射電子、オージェ電子、X 線、カソード・ルミネッセンスが発生する。走査型電子顕微鏡では、加速電圧 1k~40kV の電子線を細く絞り試料表面に照射し、2 次元的に走査させる。発生する二次電子を検出、増幅、輝度変調し、走査に同期させたブラウン管上に画像として表示させる。



図 5-1 電子線照射により試料から 発生する信号

図 5-2 傾斜コントラストの成因

2 次電子信号量はおもに試料表面の形状に依存し、試料の電位や磁気、結晶で あれば配向に依存した像となる。2 次電子はエネルギーが低いため、試料表面近く で発生したものしか表面から飛ばず、表面の形状に敏感な像が得られる。また、発 生した 2 次電子は試料表面と入射線のなす角度に依存した比率で検出器に達する。 図 5-2 の A 点で発生した 2 次電子は、表面の距離に反比例した割合で表面から 脱出でき、2 次電子の放出効率はほぼ 1/cos θ に比例する。このような傾斜効果によ り表面の凹凸による局所的な θ の変化が像のコントラストとして現れる。

走査型電子顕微鏡は金属顕微鏡と比べ被写界深度深く、観測される視野の数十 分の一に相当する深さまで焦点があった状態とみなせる。凹凸の激しい表面でも立 体的に観測することが可能である。

#### 5-2-2 走査型電子顕微鏡の装置

走査型電子顕微鏡は、大きく分けると本体部と電気系部とから構成されている。 本体部は、電子光学系、試料ステージ、2次電子検出器や電子光学系内部と試料 室を真空にするための排気系から成る。電子光学系(図 5-3)は、1k~40kV のエネ ルギーをもった細い走査電子ビームをつくるためのもので、電子銃、コンデンサレン ズ、対物レンズから構成される。また、これにビームを走査するための走査コイル等 が付属している。電気系部は、電子銃に供給する安定化高圧電源、信号増幅・処 理器等から成る。走査型電子顕微鏡の原理は、まず電子銃・電子レンズの電子光 学系により、できるだけ細い電子ビームを作り、試料面を偏向磁界によりX-Y軸走査 させる。発生した二次電子は二次電子検出器によって集められ、増幅されて表示ブ ラウン管の輝度信号となる。また、ブラウン管に写し出された画像はそのまま観察さ れるか、カメラにより写真登録される。走査型電子顕微鏡の倍率は、試料上の走査 幅とブラウン管の画面、あるいは記録写真画像の幅の比となる。



図 5-3 走査型電子顕微鏡の電子光学系

#### 5-2-3 測定結果

図 5-4 は酸化温度を変化させたとき、図 5-5 は酸化時間を変化させたときの酸 化モリブデン薄膜表面の走査型電子顕微鏡写真である。すべての走査型電子顕微 鏡写真の倍率は同じ 200 倍にしてある。

酸化温度の低い 450℃では、膜が薄くモリブデン基板の筋が見えている。500℃ 550℃ では、結晶が一様に成長している。しかし、600℃ と 650℃ ではグレインが現れている。

酸化時間が 30~120min では多くのクラックがあるが、180min ではほとんど見られない。













図 5-4 酸化温度450~650 までの酸化モリブデン薄膜表面の 電子走査型顕微鏡による写真





120 min.



180 min.

#### 図 5-5 酸化時間30~180minまでの酸化モリブデン薄膜表面の 電子走査型顕微鏡による写真

- 5-3 顕微ラマン分光法による評価
- 5-3-1 ラマン分光法の原理

試料に振動数 v 0 のレーザ光を照射し散乱光を測定すると、v 0 以外に v 0 ± v Pの不連続な弱い散乱光を観測できる。これをラマン散乱という。

レーザ光の電場に置かれた金属以外の分子は、その電子雲が変化し双極子モ ーメント(μ)が誘起される。その大きさは電場(E)に比例し、比例係数(α)を分極率と いう。

 $\mu = \alpha E$ 

電子の運動は分子振動より非常に早く、原子核の振動に常に追随しているため、 分極率は分子振動の影響を受けることになる。分極率を分子振動と無関係な部分 (α0)と分子振動によって変化する部分の和として表す。QP は各原子の変異を表す 座標である。さらに P 番目の分子振動の振動数を v P、振幅 Q<sup>0</sup><sub>P</sub>とすると、振動する 分子の分極率は、

$$\alpha = \alpha_0 + \sum_{P} \left( \frac{\partial \alpha}{\partial Q_P} \right)_0 Q_P^0 \cos 2\pi v_P t_P$$

となる。振動数 v 0 のレーザ光の電場(E)は

 $E = E^0 \cos 2\pi v_0 t$ 

となる。よってレーザ光により誘起された双極子モーメントは、

$$\mu = \alpha_0 E^0 \cos 2\pi v_0 t + \sum_p \left(\frac{\partial \alpha}{\partial Q_p}\right)_0 \left(\frac{Q_p^0 E^0}{2}\right) \left[\cos 2\pi (v_0 - v_p)t + \cos 2\pi (v_0 + v_p)t\right]$$

となる。第1項目がレーザ光と同じ振動数のレイリー散乱、第2項目の振動数 v 0- vpをストークス散乱、第3項目の振動数 v 0+ vpをアンチストークス散乱という。 ストークス散乱の強度(IS)、アンチストークス散乱の強度(IAS)とすると

 $I_{AS} = I_S \exp(-hv_P / kT)$ 

の関係があり、強度の強いストークス散乱を主に測定する。



ストークス光 アンチストークス光

図 5-6 ラマン散乱

#### 5-3-2 顕微ラマン分光装置

図 5-7 に顕微ラマン分光装置の概略図を示す。光源には、アルゴンイオンレー ザの514.5 nmの輝線を用いている。分光器に導入されたレーザは、はじめにレーザ バンドパスフィルタによって、514.5 nm 以外の成分が除去される。そして2 つの対物 レンズによって、平行なビームとなる。そして2つのミラーで、ノッチフィルタに到達し たビームは反射して、顕微鏡の光学系に導入される。ノッチフィルタはこの角度では ミラーとして働く。顕微鏡内に導入されたレーザは、下方に向きを変え、対物レンズ を通して試料に照射される。顕微鏡に取り付けられたビデオカメラによって、レーザ の焦点位置を確認でき、試料表面を見て任意の場所を測定することができる。顕微 鏡には対物レンズが 3 つあり、10 倍、50 倍、100 倍となっており、これを変えることに より、ビーム径が変わり、分解能も変わる。対物レンズ 50 倍が標準設定となっており、 このときのビーム径は数µmである。試料で反射したレーザは、同じ光路で分光器に 戻る。ここではじめにノッチフィルタに到達するが、ノッチフィルタとレーザが、この角 度であると反射せず、レーザは通過する。このとき、レーザの、波長である 514.5 nm の成分だけが除去される。つまり、レイリー光は、除去され、ラマン散乱光のみ残る。 そしてスリットにより光が絞られ、ラマン散乱光のみプリズムミラーに到達する。プリズ ムミラーに到達したラマン散乱光は、向きを変え、グレーティングにより分光される。 グレーティングは2つあり、2400本/mmと1800本/mm である。グレーティングの溝 数が多いと分解能が上がる(1.3 倍)が、固定モードで測定できる領域が小さく(0.75 倍)なる。またグレーティングの位置を制御するモータにエンコーダ付きステッピング モーターを採用しているため、グレーティングの位置精度は通常のモータより格段に 向上している。グレーティングにより分光されたラマン散乱光は、プリズムミラーで向 きを変え、CCD 検出器で光学的信号を検出される。検出器にはマルチチャンネル 型ディテクターを採用することにより、最短1/100秒でS/Nの高い測定が可能となっ ている。検出された信号は、PC によって処理され、ラマンスペクトルとして表示され る。



図 5-7 顕微ラマン分光装置概略図

5-3-3 測定結果

測定したデーターは、ローレンツ関数でフィッティングし波数を求めている。図 5-8 と図 5-9 は酸化温度を変化させたときのラマンスペクトルである。図 5-8 は波数 100~1100 cm<sup>-1</sup> まで、図 5-9 は波数 100~400 cm<sup>-1</sup> までの範囲としてある。図 5-10 と図 5-11 は酸化時間を変化させたときのラマンスペクトルであり、図 5-10 は波数 100~1100 cm<sup>-1</sup>まで、図 5-11 は波数 100~400 cm<sup>-1</sup>までの範囲である。酸化温度、 酸化時間すべての条件において波数 995, 819, 666, 473, 379, 365, 337, 291, 283, 246, 217, 198, 158, 129, 116 cm<sup>-1</sup> 付近にピークが現れている。

図 5-12 は酸化時間の変化によって波数 995, 819, 666 cm<sup>-1</sup>のピークのシフト量を 示したものである。シフト量は酸化モリブデンの粉末を基準とし、そこからの差として いる。基準となる酸化時間が長くなるにしたがって低波数側にシフトしている。波数 337 291 283 158 129 116 cm<sup>-1</sup>付近のピークについても同様の傾向が見られた。







5-4 X線回折法による評価

5-4-1 X 線回折の原理

X線回折測定は結晶のなどの原子配列に関する情報を測定する分析手法である。 そのため、試料に含まれている元素の種類や量を知ることはできない。

X 線が結晶に照射されると、結晶格子面で回折、干渉が起きブラッグの回折条件 を満たす方向の回折線の強度が強まり、その他は打ち消しあい観測されない。原子 が平行に並んでいる原子網面の間隔を d、網面に対する入射角と反射角  $\theta$ とすると、 光路差 2d sin  $\theta$  が波長の正数倍 n $\lambda$ のとき、隣接する原子網面からの散乱波の位 相がそろい回折現象を生じる。つまり、式 2d sin  $\theta$  = n $\lambda$ となるときである。多結晶で は n=1 として面間隔 d を求める。面間隔 d は一般に物質固有の値であるため、一つ の物質から数個の d とそれに対応する X 線回折の相対強度が測定できれば、その 物質を同定することができる。

あらかじめサンプルの物質が予想できる場合は、既知物質のX線回折データと比較することで同定することができ、結晶性が良好であれば2種類以上の混合サンプルでもそれぞれを同定することができる。また、同じ化学組成を持ちながら構造の異なるサンプルであってもそれぞれを同定することができる。

X 線回折法は資料中の原子の規則性を測定しているため、同じ結晶構造を持つ 物質でもその結晶化の程度より X 線回折強度は変化する。結晶性の良い物質の回 折強度は強く鋭いが、悪い物質は弱くブロードになる。



図 5-13 ブラッグの条件

#### 5-4-2 X 線回折測定装置

X線回折測定装置はX線発生部、ゴニオメータ、X線検出器、計数装置、システ ムコントローラ、コンピュータシステムで構成されている。X 線回折装置のゴニオメー タは独立に回転する軸を2つもち、試料面へのX線の入射角と反射角が等しくなる よう X 線検出器が試料の 2 倍の速さで回転するようにシステムコントローラで制御さ れている。X 線源から発生した X 線はソーラ・スリット、発散スリットを通り、細い平行 ビームとなって試料に入射する。試料に入射した X線は回折現象を起こす。回折光 (反射光) は受光スリット、ソーラ・スリット、散乱スリットを通りシンチレーション・カウン タで検出される。検出されたX線は計数装置、システムコントローラを経てコンピュー タシステムに記録される。X 線源から X 線は完全な平行光ではなく分散と呼ばれる 広がりを持っているため、各スリットを用いて分散を制限、制御し空間分解能を改善 させている。発散スリットは水平方向の分散を制限し、散乱スリットは水平方向の分散 を制御している。受光スリットは測定の空間分解能を決めている。ソーラ・スリットは回 折面に垂直な方向の分散を制限している。シンチレーション・カウンタはX線が入射 すると蛍光を発する。蛍光を発する物質は Nal 単結晶が使われ、X 線量のエネルギ ーに比例した光子数を発生させる。発生した光子は電気量に変えられ電圧パルス になる。回折現象はブラッグの回折条件を満足するかぎられた方向に非常に強い回 折光が現れる。回折光の現れた反射角 2θを標準物質の回折データと照らし合わ せることで、試料中に目的の結晶物質が含まれているか容易に確かめることができ る。また、回折現象によって結晶構造や結晶方位なども調べることもできる。



図 5-14 X線回折装置の概略

5-4-3 測定結果

2θが 50°以降の高角度になるに従い物質の同定や指数付けの困難なピークが 多数表れた。そのため、ピークの変化が端的にわかる 2θが 10°~50°程度の範 囲で測定を行っている。測定したデータは、ガウス関数でフィッティングし JCPDS フ ァイルを参照することで生成物の同定、指数付けを行った。その結果、ピークのほと んどは MoO<sub>3</sub> であった。

図 5-15 は、酸化温度を変化させたときの X 線回折測定結果である。酸化温度が 低い 450℃では、40.5°に基板であるモリブデンの Mo(110)のピークと 23.3°に MoO<sub>3</sub>(110)の強いピークが現れている。温度が上昇するに従いそれらのピーク強度 は弱くなり、Mo(110)のピークは 550℃、MoO<sub>3</sub>(110)のピークは 600℃ではほとんど観 測できなくなる。それらのピークに代わって 12.8°の MoO<sub>3</sub>(020)、25.7°の MoO<sub>3</sub>(040)、39.0°の MoO<sub>3</sub>(060)の 3 つのピークが支配的になっていく。

図 5-16 は、酸化時間を変化させたときの X 線回折測定の結果である。酸化時間 30 分では強度の強い MoO<sub>3</sub>(110)以外に多くのピークが現れているが、酸化時間が 長くなると 45.8°の MoO<sub>3</sub>(200)の強度が強くなり、MoO<sub>3</sub>(110)と MoO<sub>3</sub>(200)の 2 つの 面に収まっていく。

図 5-17 は X 線回折測定の結果から、酸化温度を変化させた時と酸化時間を変

化させた時の主なピークの半値幅をプロットしたものである。酸化温度が高くなるに したがい、半値幅は減少し結晶性の向上が見られる。酸化時間を変化させた場合、 120minの半値幅が狭く、結晶性が良い。





図 5-16 酸化温度を変えた時のX線回折測定の半値幅



図 5-17 酸化時間を変えた時のX線回折測定の半値幅

#### 5-5 測定結果の考察

X線回折測定では、多くの条件で数多くのピークが存在することが確認できる。酸 化温度が低い場合、(110), (021), (110)など異なる結晶方向からの回折が多数測定 されることと、走査型電子顕微鏡写真から表面の凹凸が存在することから多結晶で あると考えられる。

酸化温度が 500℃と 600℃を境に、結晶面が変わり(020), (040), (060)と同じ結晶 方向からの回折が測定される。走査型電子顕微鏡で観察すると、550℃ から 600℃ になると表面の均一性が悪くなり、200µm 程度の成長したグレインを確認できる。ま た、酸化時間が長くなるにしたがい(200)の回折の強度は増加し、走査型電子顕微 鏡で観察すると、表面の均一性の向上が見られる。そのことから、X 線回折測定は 酸化モリブデン薄膜の表面形状に大きく影響を受けており、測定結果から表面形状 をある程度推測することができると考えられる。

X線回折測定の指数付けにより酸化モリブデン薄膜の主な組成を MoO<sub>3</sub>と決定したたが、確認のためにラマン分光法による測定も行った。図 5-8~11 参照。観測された波数 995, 819, 666, 473, 379, 365, 337, 291, 283, 246, 217, 198, 158, 129, 116 cm<sup>-1</sup> 付近のピークは、M.A.PY とK.Maschke の報告の中に書かれた MoO<sub>3</sub> のピーク位置と一致した。よって、酸化モリブデン薄膜の組成は MoO<sub>3</sub> でほぼ間違いないと考えられる。

ラマン分光法による測定から酸化時間を変化させたときの各ラマンピークのシフト 量(図 5-12)を求めたところ、酸化時間 30min のとき一番大きく、時間ともに小さくな った。このラマンピークのシフト量は応力と関係があり、一般的に引張応力が作用す ると原子間隔が拡がって結合力が弱まり振動数が小さくなる。したがってラマンピー クは低波数側にシフトすることになる。圧縮応力が作用する場合は、この関係は逆に なる。酸化モリブデンが一般論に従うと仮定すると、酸化時間 30min のとき最も強い 圧縮応力が働いていることになる。走査型電子顕微鏡で酸化時間 30min の表面を 観察するとクラックが発生しており、結晶の重なりからクラックの発生している部分は、 周りより高くなっていることから、圧縮応力により発生したものと考えて差し支えないと 思われる。酸化モリブデン薄膜に生じるクラックは圧縮応力によると考えられる。

5-6 まとめ

作製した酸化モリブデン薄膜は、X 線回折法から多結晶の MoO3 であることがわかった。組成はラマン分光方により確認できた。X 線回折と走査型電子顕微鏡写真から、酸化モリブデン薄膜の表面形状には相関関係があることがわかった。ラマン分光法と走査型電子顕微鏡による観察から、酸化モリブデン薄膜に生じたクラックは 圧縮応力によることがわかった。

## 第6章

### 本論文の結論

あまり研究の行われていない酸化モリブデンの基礎的な性質を明らかにするため、 酸化装置を製作し、酸化を行った。

熱酸化で作製した酸化モリブデン薄膜は、主に MoO<sub>3</sub> から構成された多結晶であ り、酸化温度 550℃ で約 0.11 μm/min の成長速度を持つことがわかった。

さらに酸化条件を変え実験を行うことで、より多くの基礎的な性質を得ることができ ると考えている。 参考文献

[1] 塩川二郎: 機器分析の手引き ㈱化学同人

[2] 浜口宏夫 平川暁子: 日本分光学会測定法シリーズ 17 ラマン分光法 株式会社学会 出版センター

[3] 根元邦治 岩木龍一 大山英典: 半導体デバイス入門 森北出版株式会社

[4] 加藤誠軌: セラミックス基礎講座3 X線回折分析 株式会社内田老鶴圃

[5] Martin Lerch: In Situ Resonance Raman Studies of Molybdenum Oxide Based Selective Oxidation Catalysts

[6] 日本真空協会関西支部:わかりやすい真空技術-第2版- 日刊工業新聞社

[7] 石川和雄: 真空技術入門 共立出版株式会社

[8] M. A. Py and K. Maschke, Physica B 105, p. 376 (1981)

#### 謝辞

本研究は、高知工科大学電子・光エレクトロニクス工学科において河東田教授の御 指導の下に行われたものである。研究に際し、終始適切な御指導、御鞭撻を賜りました。河東田教授には深甚なる感謝の意を表します。

本研究の遂行に当たり、終始熱心な御指導、適切な御助言を賜りました西田助手に深甚なる感謝の意を表します。

本研究の遂行にあたり、多大な協力をして頂いただき、終始有益な御討論をして頂いた酸化物グループの赤木敏和氏に甚大なる感謝の意を表します。

研究推進、学生生活を送る際に多大な協力をして頂いた、河東田研究室の修士 2 年の安部智規氏、熊谷耕一氏、白川宰氏、松岡学氏、河野巧氏、寺西正臣氏に感謝 いたします。

最後に、本研究の遂行に当たり様々な形で御協力をして頂いた河東田研究室の修士 1年の白方健氏、杉野友紀氏に感謝いたします。